

半桥栅驱动芯片

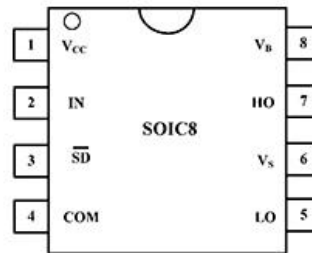
概述

PN7104 是一款基于 P 衬底、P 外延的高压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动芯片。其浮地通道能工作在 600V 的高压下,可用于驱动 2 个 N 型功率 MOSFET 或 IGBT 组成的半桥结构。该芯片逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。输出具有大电流脉冲能力。传输延时具有匹配性,以简化在高频下的应用。

特征

- 高压范围达+600 V
- 3.3 V 逻辑兼容
- 抗 dV/dt 能力 ± 50 V/nscc
- 自举工作的浮地通道
- 栅驱动电压范围 10V~20V
- 低侧欠压保护 (UVLO) 功能
- 输出拉灌电流能力 400mA/650mA
- 520ns 内部固定死区时间,以进行防穿通保护
- 抗-10V 瞬态负 V_s 能力
- 高低侧通道均延时匹配

封装/订购信息

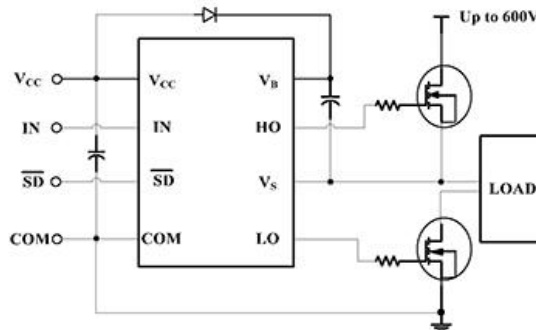


型号	订购代码	封装
PN7104	PN7104SEC-R1	SOIC8

应用领域

- 中小型功率电机驱动
- 功率 MOSFET 或 IGBT 驱动

典型应用



(Refer to Lead Assignments for correct pin configuration. This diagram shows electrical connections only.)